



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HS882**

对应国外型号  
2SD882

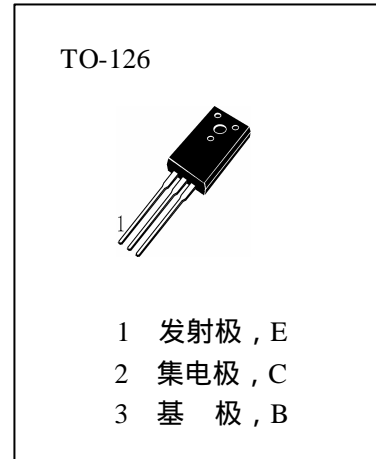
### 主要用途

音频放大、开关功率放大

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极功率耗散 ( $T_c=25$ ) .....	10W
$P_C$ ——集电极功率耗散 ( $T_A=25$ ) .....	1W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	40V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	30V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	5V
$I_C$ ——集电极电流.....	3A
$I_B$ ——基极电流.....	0.6A

### 外形图及引脚排列



### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			1	$\mu A$	$V_{CB}=30V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			1	$\mu A$	$V_{EB}=5V, I_C=0$
$h_{FE}$	直流电流增益	60		400		$V_{CE}=2V, I_C=1A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		0.3	0.5	V	$I_C=2A, I_B=0.2A$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降		1.0	2	V	$I_C=2A, I_B=0.2A$
$C_{ob}$	输出电容		45		pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$
$f_T$	特征频率		90		MHz	$V_{CE}=5V, I_E=0.1A$

### 分档及其标志

R	Q	P	E
60—120	100—200	160—320	200—400



典型特性曲线

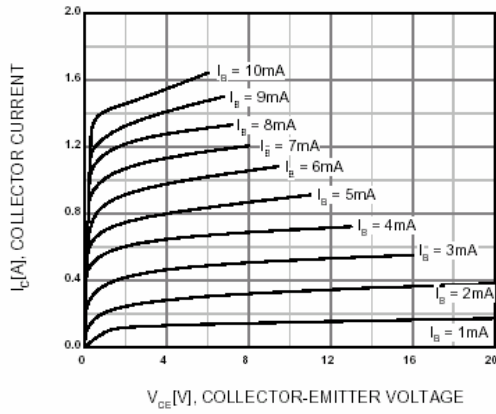


Figure 1. Static Characteristic

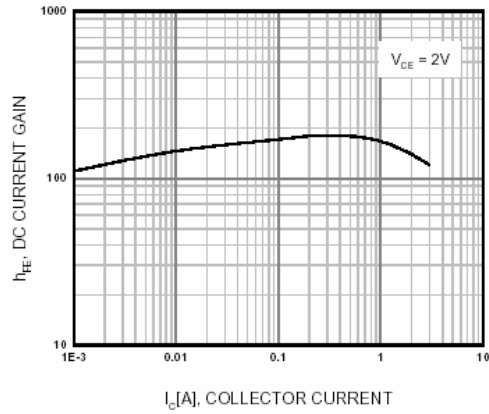


Figure 2. DC current Gain

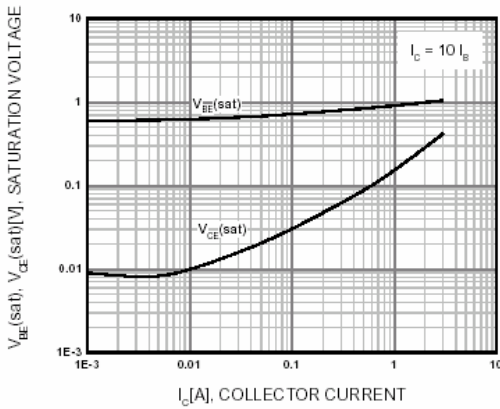


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage  
Collector-Emmitter Saturation Voltage

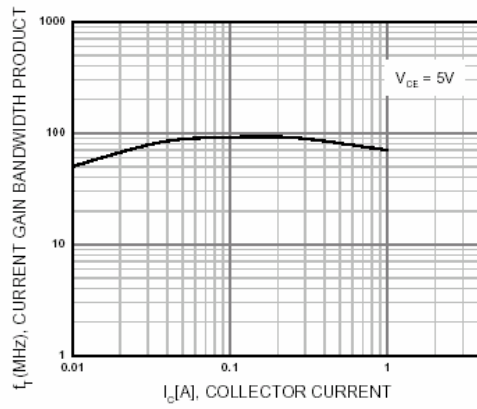


Figure 4. Current Gain Bandwidth Product

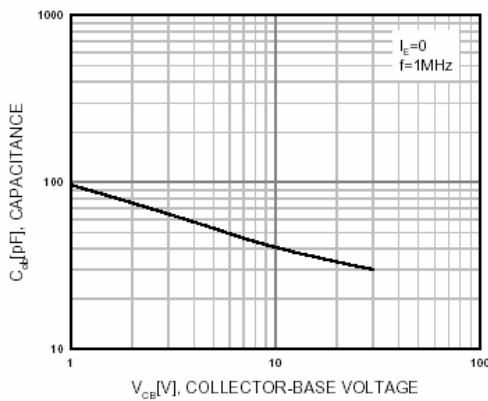


Figure 5. Collector Output Capacitance

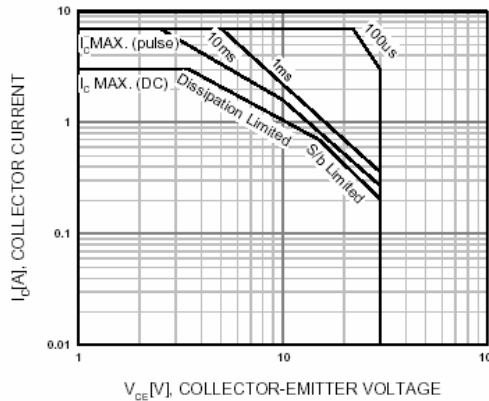


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HS882

对应国外型号  
2SD882

### 典型特性曲线

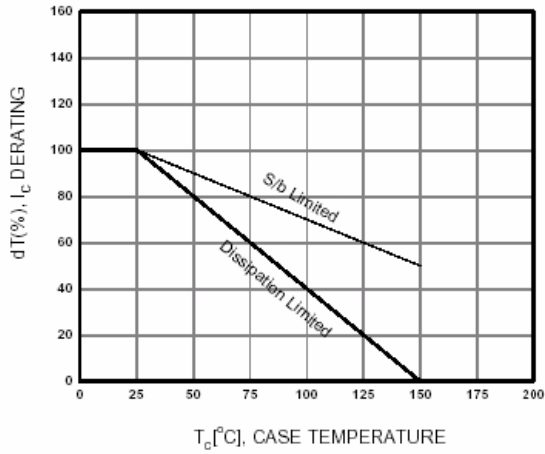


Figure 7. Derating Curve Of Safe Operating Areas

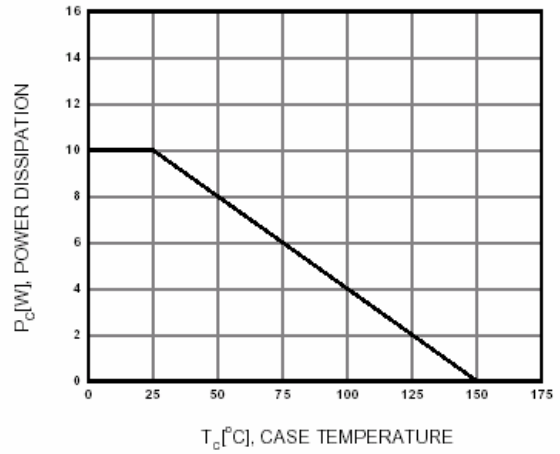


Figure 8. Power Derating